# 特許協力条約

#### 発信人 日本国特許庁 (国際調査機関)

代理人

細田 益稔

様

RECEIVED JL. 27. 2005 M.HOSODA

PCT 国際調査機関の見解書 (法施行規則第40条の2)

[PCT規則43の2.1]

あて名

〒107-0052

東京都港区赤坂二丁目17番22号 赤坂ツインタワー本館11F

発送日

(日.月.年)

26. 7. 2005

出願人又は代理人

の書類記号

. )

05P00117W0

今後の手続きについては、下記2を参照すること。

国際出願番号

PCT/JP2005/006692

国際出願日

(日.月.年) 30.03.2005

優先日

(日.月.年)

31.03.2004

4 G

8216

国際特許分類 (IPC) Int.CL<sup>7</sup> C30B29/38, <sup>9</sup>//。

出願人 (氏名又は名称)

日本碍子株式会社

1. この見解書は次の内容を含む。

▼ 第 Ⅰ欄 見解の基礎

第Ⅱ欄 優先権

第皿欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成

「 第IV欄 発明の単一性の欠如

第V欄 PCT規則 43 の 2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、

それを裏付けるための文献及び説明

第VI欄 ある種の引用文献

第VI欄 国際出願の不備

「第1個個 国際出願に対する意見

2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国 際予備審査機関がPCT規 66.1 の 2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさ ない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日か ら3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く演了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当 な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日

01.07.2005

名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 特許庁審査官(権限のある職員)

真々田 忠博

電話番号 03-3581-1101 内線 3416

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

国际嗣任機関の見解書			国際出願番号	PCT/JP2005/00669		
第1欄 見解の基礎						
1. この見解書は、	下記に元	<b>ミマン・スター・スター・スター・スター・スター・スター・スター・スター・スター・スター</b>	礎として作成さ	nt.		
厂 この見解書 それは国際調		語による翻訳文を基礎と めに提出されたPCT規則12. 3及び23. 1 (	して作成した。 b)にいう翻訳文	の言語である。		
2. この国際出願で 以下に基づき見が	閉示され 解書を作	かつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌ 成した。	クレオチド又は	アミノ酸配列に関して、		
a. タイプ	Г	配列表				
	Γ	配列表に関連するテーブル				
b. フォーマット	Γ	書面				
	_	コンピュータ読み取り可能な形式		·		
c.提出時期	Γ	出願時の国際出願に含まれる		**		
	_	この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された				
	Γ	出願後に、調査のために、この国際調査	<b>E機関に提出され</b>	it.		
3. 「 さらに、配列3 た配列が出籍時	を又は配 まに提出	列表に関連するテーブルを提出した場合 1 た配列と同一でもより、7000 (1987)	に、出願後に提	出した配列若しくは追加して提出し		

## 4. 補足意見:

### 国際調査機関の見解書

国際出願番号 PCT/JP2005/006692

これを設ける文献及び説	上の利用可能性につ 明	DVVてのPCT規則 43 の 2. 1 (a) (i) に	定める見解、 
1. 見解			
新規性 (N)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	1-7	
進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲	1-7	
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 請求の範囲	1-7	

### 2. 文献及び説明

文献 1: WO 2004/013385 A1(財団法人大阪産業振興機構) 2004.02.12

国際調査報告で引用した文献 1 には、ナトリウム金属を含むフラックスを用いて、GaN 単結晶を育成するに当たり、温度  $100\sim1200$  ℃、圧力  $100\sim200$  M Pa で反応を行うことが記載されており、本願発明で採用する反応条件と重複するものであり、重複する範囲で請求項 1-7 にかかる発明は新規性と進歩性を有さない。